

## 大見研究室 和文 論文リスト

2014 年
--------

- 1271(C) 前田 康貴、湯澤 康介、大見 俊一郎、後藤 哲也、大見 忠弘、「窒素添加 LaB<sub>6</sub> 界面層によるペンタセンの n 型特性に関する検討」、第 61 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集、(公益社団法人応用物理学会)、12-052、(19p-E5-20)、2014 年 3 月。
- 1272(F) 吉川和博、片川大輔、渡辺直也、青柳昌宏、酒井健、吉田達朗、大見忠弘、「高スループット・低コスト・シリコン貫通電極露出工程のためのスピン・高速エッチング技術の開発」、電子情報通信学会論文誌、Vol.J97-C No.7、(一般社団法人電子情報通信学会)、pp.298-305、2014 年 7 月。
- 1273(C) 前田康貴、大見俊一郎、後藤哲也、大見忠弘、「窒素添加 LaB<sub>6</sub> 薄膜上に形成したペンタセン薄膜の堆積温度依存性」、第 75 回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集、(公益社団法人応用物理学会)、12-004、(17a-A5-4)、2014 年 9 月。
- 1274(W) 諏訪智之、寺本章伸、須川成利、大見忠弘、「ラジカル窒化法により形成した Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si 界面に形成される組成遷移層に関する研究」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.114、No.255、シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会)、SDM2014-89(2014-10)、pp.31-34、2014 年 10 月。
- 1275(W) 小原俊樹、寺本章伸、黒田理人、米澤彰浩、後藤哲也、諏訪智之、須川成利、大見忠弘、「MOSFET におけるランダムテレグラフノイズを引き起こすトラップ密度の解析に関する研究」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.114、No.255、シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会)、SDM2014-93(2014-10)、pp.55-59、2014 年 10 月。
- 1276(W) 大見忠弘、平山昌樹、後藤哲也、「シリコン LSI や薄膜シリコン太陽電池の性能を劇的に向上させる新しい製造装置」、第 26 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.33-82、2014 年 10 月。